



# 《风光欣》技术资料

\*\*\*\*\*

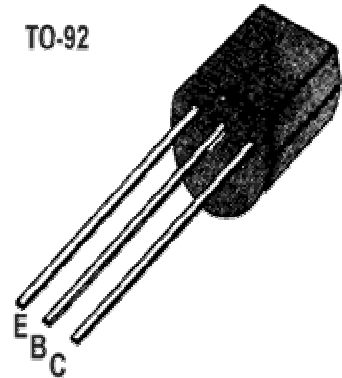
## S 9013

### NPN EPITAXIAL SILICON TRANSISTOR

主要用途:音频放大等。

绝对最大额定值 ( Ta=25 )

| 项 目       | 符号        | 额定值      | 单位 |
|-----------|-----------|----------|----|
| 集电极-基极电压  | $V_{CB0}$ | 40       | V  |
| 集电极-发射极电压 | $V_{CEO}$ | 20       | V  |
| 发射极-基极电压  | $V_{EBO}$ | 5        | V  |
| 集电极电流     | $I_c$     | 500      | mA |
| 集电极耗散功率   | $P_c$     | 625      | mW |
| 结 温       | $T_J$     | 150      |    |
| 存储温度      | $T_{STG}$ | -55 ~150 |    |



电参数 ( Ta=25 )

| 项 目         | 符号            | 测试条件                   | 最小值 | 典型值  | 最大值 | 单位 |
|-------------|---------------|------------------------|-----|------|-----|----|
| 集电极-基极击穿电压  | $BV_{CB0}$    | $I_c=100 \mu A, I_E=0$ | 40  |      |     | V  |
| 集电极-发射极击穿电压 | $BV_{CEO}$    | $I_c=1mA, I_B=0$       | 20  |      |     | V  |
| 发射极-基极击穿电压  | $BV_{EBO}$    | $I_E=100 \mu A, I_c=0$ | 5   |      |     | V  |
| 集电极-基极截止电流  | $I_{CB0}$     | $V_{CB}=25V, I_E=0$    |     |      | 100 | nA |
| 发射极-基极截止电流  | $I_{EBO}$     | $V_{EB}=3V, I_c=0$     |     |      | 100 | nA |
| 直流电流增益      | $h_{FE1}$     | $V_{CE}=1V, I_c=50mA$  | 64  | 120  | 202 |    |
|             | $h_{FE2}$     | $V_{CE}=1V, I_c=500mA$ | 40  | 120  |     |    |
| 集电极-发射极饱和压降 | $V_{CE(sat)}$ | $I_c=500mA, I_B=50mA$  |     | 0.16 | 0.6 | V  |
| 基极-发射极饱和压降  | $V_{BE(sat)}$ | $I_c=500mA, I_B=50mA$  |     | 0.91 | 1.2 | V  |
| 基极-发射极电压    | $V_{BE(on)}$  | $V_{CE}=1V, I_c=10mA$  | 0.6 | 0.67 | 0.7 | V  |

Hfe 分档及其标志

| 分档          | D     | E      | F      | G       | H       |
|-------------|-------|--------|--------|---------|---------|
| $H_{FE(1)}$ | 69-91 | 78-112 | 96-135 | 112-166 | 144-202 |